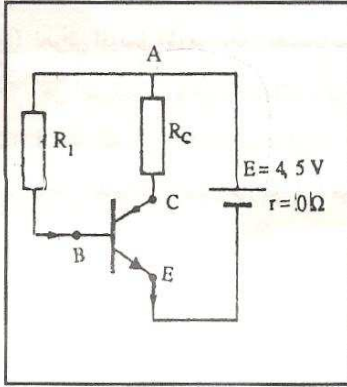


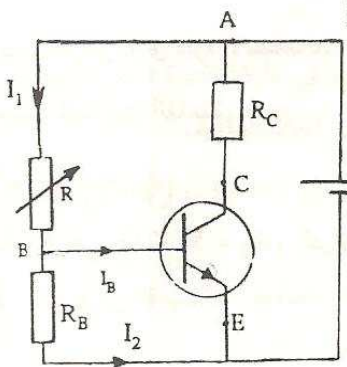
سلسلة الترانزستور

تمرين-1



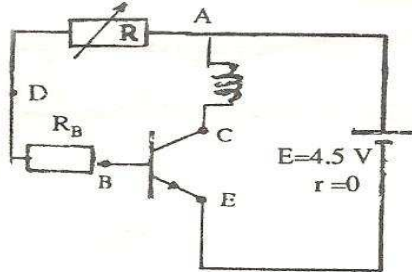
- تعتبر التركيب الممثل جانبه. عندما يشتغل الترانزستور في الحالة العادية، يكون معامل تضخيم التيار $\beta = 100$ و التوتر $U_{BE} = 0,7 \text{ V}$ ثابت. $R_C = 100 \Omega$.
- (1) شدة التيار في دائرة المجمع $I_C = 30 \text{ mA}$ و الترانزستور يشتغل في الحالة العادية.
- (1.1) أوجد قيمة U_{CE} ، التوتر بين الباعث و المجمع.
- (2) أوجد قيمة شدة التيار في دائرة القاعدة.
- (3.1) استنتج قيمة المقاومة R_1 .
- (2) عوض الموصل الأومي ذي المقاومة R_1 بموصل أومي مقاومته $R_2 \approx 7,2 \text{ K} \Omega$.
- حدد حالة اشتغال الترانزستور، علما أن شدة التيار في دائرة القاعدة هي $I_{B2} = 0,5 \text{ mA}$.

تمرين-2



- تعتبر التركيب الممثل جانبه. تركيبا إلكترونيا يضم ترانزستور له تضخيم لتيار $\beta = 200$ و توتر العتبة للوصلة (B - E) : $U_{BE0} = 0,6 \text{ V}$. نعطي:
- $R_B = 1 \text{ k} \Omega$ و $R_C = 500 \Omega$ و R قابلة للضبط.
- (1) أوجد شدة تيار الاشباع في دائرة المجمع.
- (2) لضبط R عند قيمة $R_1 = 13 \text{ K} \Omega$ فنحصل على $U_{BE} = 0,8 \text{ V}$.
- (1.2) أوجد I_B شدة التيار في القاعدة.
- (2.2) استنتج قيمة التوتر U_{CE} .
- (3) لضبط R عند القيمة R_2 التي توافق بداية حالة الاشباع. أوجد R_2 ، علما أن $U_{BE} \approx 0,85 \text{ V}$.

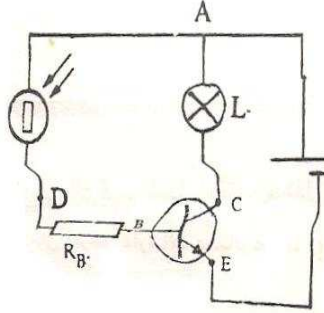
تمرين-3



- في التركيب الممثل أسفله، يشتغل الترانزستور في النظام الخطي. التوتر $U_{BE} = 0,7 \text{ V}$ ثابت و $\beta = 50$ ومقاومة المرحل $R_C = 300 \Omega$.
- يفتح المرحل دائرة الاستعمال عندما يمر في وشيعته تيار شدته أكبر من $I_c = 10 \text{ mA}$ ، ويفتحها عندما تكون شدة التيار أصغر من $I_d = 4 \text{ mA}$.
- نعطي: $R_B = 560 \Omega$ و R قابلة للضبط.
- (1) التوتر $U_{CE} = 0,9 \text{ V}$ و $R = R_1$.
- (1.1) بين أن المرحل يفلق دائرة الاستعمال.
- (2.1) أوجد شدة تيار القاعدة.
- (3.1) استنتج قيمة R_1 .
- (2) قيمة R هي $R_2 = 50 \text{ K} \Omega$ و الترانزستور غير متوقف. بين أن المرحل يفتح دائرة الاستعمال

تمرين-4

تعتبر التركيب المبين أسفله. عند الاشتغال العادي للترانزستور، يكون معامل تضخيم التيار $\beta = 100$ و التوتر $U_{BE} \approx 0.6 \text{ V}$. يضيء المصباح L عندما يجتازه تيار شدته $I = 0.3 \text{ A}$. للمقاومة الضوئية في الظلام، مقاومة $R_1 = 10^6 \Omega$ و في الضوء مقاومة $R_2 = 300 \Omega$. مولد G قوته الكهرومحرركة $E \approx 4,5 \text{ V}$ ومقاومته مهملة.



(1) المقاومة الضوئية في الضوء و المصباح مضيء.

(1.1) أحسب شدة تيار دائرة القاعدة.

(2.1) استنتج قيمة R_B .

المقاومة الضوئية في الظلام، بين أن المصباح لا يضيء.

(3) اقترح استعمالات ممكنة لهذا التركيب.

تمرين-5

نعتبر التركيب الممثل أسفله. خلال الاشتغال العادي للترانزستور، يكون معامل تضخيم التيار $\beta = 200$ و التوتر $U_{BE} = 0.6 \text{ V}$. يتطلب تشغيل المصباح L تيارا شدته $I = 0.2 \text{ A}$. للمقاومة الحرارية، عند درجة الحرارة $\theta_1 = 20^\circ \text{C}$ ، مقاومة

$R_1 = 600 \Omega$ وعند $\theta_2 = 60^\circ \text{C}$ ، مقاومة $R_2 = 200 \Omega$.

(1) المقاومة الحرارية عند درجة الحرارة θ_1 و المصباح مضيء.

(1.1) أحسب شدة التيار في القاعدة.

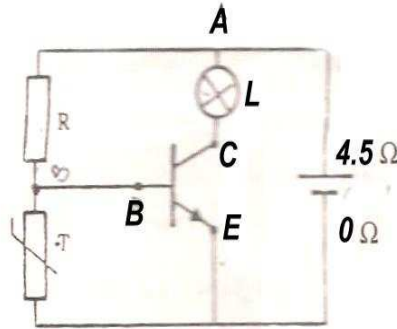
(2.1) أوجد I_1 ، شدة التيار في الموصل (AB).

(3.1) استنتج قيمة R، مقاومة الموصل الأومي (AB).

(2) المقاومة الحرارية عند درجة الحرارة θ_2 .

(1.2) بين أن الترانزستور متوقف.

(2.2) اقترح بعض الاستعمالات الممكنة لهذا التركيب.



حلول سلسلة الترانزيستور

تمرين-1

نحصل على : $E = R_1 \cdot I_{B1} + U_{BE}$
 نستنتج : $R_1 = \frac{E - U_{BE}}{I_{B1}}$
 ت. ع. نجد : $R_1 = 10^4 \Omega$
 (4) نلاحظ أن شدة التيار في دائرة القاعدة قد زادت. إذن لا يمكن للترانزستور أن يشتغل إلا في الحالة العادية أو أن يصير مشبعاً.
 نحدد القيمة القصوى I_{Bmax} التي توافق بداية حالة الإشباع حيث :
 $U_{CE} = 0$
 * في دائرة المجمع : $E = R_C \cdot I_{Csat} + 0$
 نحصل على : $I_{Csat} = 4,5 \cdot 10^{-2} A$
 * الشدة القصوى I_{Bmax} هي حيث : $I_{Bmax} (I_{csat}) = \frac{I_{csat}}{\beta}$
 نحصل على : $I_{Bmax} = 4,5 \cdot 10^{-4} A$
 * $I_{Bmax} < I_{B2}$ إذن الترانزستور في حالة الإشباع .

يكتب قانون إضافية التوترات في دائرة المجمع :

$$E = U_{AC} + U_{CE}$$

يكتب قانون أوم ، بالنسبة للموصل الأومي (AC) :

$$U_{AC} = R_C \cdot I_C$$

نحصل على : $E = R_C \cdot I_C + U_{CE}$

$$U_{CE} = E - R_C \cdot I_C$$

ت. ع. نجد : $U_{CE} = 1,5 V$ ، $I_C = 3 \cdot 10^{-2} A$

(2) بما أن الترانزستور يشتغل في الحالة العادية ، نكتب :

$$I_C = \beta \cdot I_{B1}$$

$$I_{B1} = \frac{I_C}{\beta} \quad \text{عدديا : } I_{B1} = 3 \cdot 10^{-4} A$$

(3) يكتب قانون إضافية التوترات بين A و E :

$$U_{AE} = U_{AB} - U_{BE}$$

$$U_{AB} = R_1 \cdot I_{B1} \quad \text{و} \quad U_{AE} = E$$

تمرين-2

(2.2) نفترض أن الترانزستور يشتغل في الحالة العادية .

$$I_C = 1,2 \cdot 10^{-2} A \quad \text{إذن} \quad I_C = \beta \cdot I_B \quad \text{عدديا، نحصل على :}$$

$$I_C < I_{Csat} \quad \text{، افتراضنا إذن صحيح.}$$

(3) نكتب قانون إضافية التوترات في دائرة المجمع :

$$E = R_C \cdot I_C + U_{CE}$$

$$U_{CE} = E - R_C \cdot I_C \quad \text{نحصل على :}$$

$$U_{CE} \approx 6 V \quad \text{ت. ع. نجد :}$$

$$I_B = \frac{I_{csat}}{\beta} \quad \text{عند بداية حالة الاشباع، نكتب :}$$

وانطلاقاً من تعبير I_B ، المحصل عليه في السؤال 1.2 ، ويتعويض

$$I_{csat} \cdot \frac{E - U_{BE}}{\beta} = \frac{U_{BE}}{R_2} - \frac{U_{BE}}{R_B} \quad \text{نكتب :}$$

$$R_2 = \frac{\beta \cdot R_B (E - U_{BE})}{R_B \cdot I_{csat} + \beta \cdot U_{BE}} \quad \text{نحصل على :}$$

$$R_2 \approx 11500 \Omega \quad \text{ت. ع. نجد :}$$

(1) يكتب قانون إضافية التوترات في دائرة المجمع :

$$E = U_{AC} + U_{CE}$$

باعتبار قانون أوم نكتب : $U_{AC} = R_C \cdot I_C$

عند الاشباع : $I_C = I_{Csat}$ و $U_{CE} = 0$

نحصل على : $E = R_C \cdot I_{Csat}$

$$I_{Csat} = 2,4 \cdot 10^{-2} A \quad \text{عدديا :} \quad I_{Csat} = \frac{E}{R_C}$$

(1.2) باعتبار قانون العقد عند B ، نكتب : $I_B = I_1 - I_2$

$$\text{لدينا :} \quad I_1 = \frac{U_{AB}}{R_1} \quad \text{حيث :} \quad U_{AB} = U_{AE} - U_{BE}$$

$$\text{أي :} \quad U_{AB} = E - U_{BE} \quad \text{إذن :} \quad I_1 = \frac{E - U_{BE}}{R_1}$$

$$\text{ولدينا :} \quad U_{BE} = R_B \cdot I_2 \quad \text{أي} \quad I_2 = \frac{U_{BE}}{R_B}$$

$$I_B = \frac{E - U_{BE}}{R_1} - \frac{U_{BE}}{R_B} \quad \text{نحصل على :}$$

$$I_B \approx 6,2 \cdot 10^{-5} A \quad \text{ت. ع. نجد :}$$

تمرين-3

$$E = R_1 \cdot I_B + R_B \cdot I_B + U_{BE} \quad \text{نحصل على :}$$

$$R_1 = \frac{E - U_{BE}}{I_B} - R_B \quad \text{نستنتج :}$$

$$R_1 \approx 1,753 \cdot 10^4 \Omega \quad \text{ت.ع, } U_{BE} = 0,7 \text{ V نجد}$$

(2) نلاحظ أن قيمة R قد زادت ($R_2 > R_1$) ، إذن قيمة I_B نقصت. الترانزستور غير متوقف. إذن لا يمكنه أن يشتغل إلا في النظام الخطي ($U_{BE} = 0,7 \text{ V}$). يكتب قانون إضافية التوترات في دائرة القاعدة :

$$E = R_2 \cdot I_B + R_B \cdot I_B + U_{BE}$$

$$I_B = \frac{E - U_{BE}}{R_2 + R_B} \quad \text{نحصل على}$$

$$I_C = \beta \frac{E - U_{BE}}{R_2 + R_B} \quad \text{لدينا } I_C = \beta I_B \text{ أي}$$

$$I_C \approx 3,7 \cdot 10^{-3} \text{ A} \approx 3,7 \text{ mA} \quad \text{عدديا, نحصل على}$$

$I_C < I_d$ المرسل يفتح دائرة الاستعمال.

(1.1) نحدد شدة التيار الذي يجتاز وشعية المرسل، وهو تيار المجمع :

$$E = U_{AC} + U_{CE} \quad \text{- يكتب قانون إضافية التوترات :}$$

$$U_{AC} = R_C \cdot I_C \quad \text{- باعتبار قانون أوم, نكتب :}$$

$$E = R_C \cdot I_C + U_{CE} \quad \text{- نحصل على :}$$

$$I_C = \frac{E - U_{CE}}{R_C} \quad \text{نستنتج :}$$

$$I_C = 12 \text{ mA} \quad \text{أو } I_C = 1,2 \cdot 10^{-2} \text{ A} \quad \text{نجد, عدديا,}$$

$I_C > I_c$: المرسل إذن يغلق دائرة الاستعمال.

(2.1) $I_C \neq 0$ و $U_{CE} \neq 0$: الترانزستور إذن يشتغل في الحالة

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \quad \text{نكتب } I_B \approx 2,4 \cdot 10^{-2} \text{ A} \quad \text{عدديا, نجد}$$

(3.1) يكتب قانون إضافية التوترات في دائرة القاعدة :

$$U_{AE} = E = U_{AD} + U_{DB} + U_{BE}$$

باعتبار قانون أوم, نكتب :

$$U_{DB} = R_B \cdot I_B \quad \text{و } U_{AD} = R_1 \cdot I_B$$

تمرين-4

(1.1) التيار المار عبر المصباح هو تيار المجمع. شدته :

$$I_C = I = 0,3 \text{ A}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \quad \text{إذا اعتبرنا اشتغال الترانزستور في النظام الخطي, نكتب :}$$

$$I_B = 3 \cdot 10^{-2} \text{ A} \quad \text{نجد}$$

(2.1) يكتب قانون إضافية التوترات بين A و E :

$$U_{AE} = U_{AD} + U_{DB} + U_{BE}$$

$$U_{AD} = R_2 \cdot I_B \quad \text{و } U_{AE} = E \quad \text{باعتبار قانون أوم, نكتب :}$$

$$U_{DB} = R_B \cdot I_B$$

$$E = R_B \cdot I_B + R_2 \cdot I_B + U_{BE} \quad \text{نحصل على :}$$

$$R_B = \frac{E - U_{BE}}{I_B} - R_2 \quad \text{نستنتج :}$$

$$R_B = 1000 \Omega \quad \text{ت.ع, نجد}$$

(2) بالنسبة للمقاومة الضوئية، تزداد مقاومتها عند تكون في

الظلام. وبالتالي فإن شدة التيار في دائرة القاعدة تنقص. فيصير الترانزستور متوقفا أو يبقى في الحالة العادية.

* إذا كان الترانزستور متوقفا فإن $I_B = 0$ ، وبالتالي المصباح إذن يضيئ.

* إذا كان الترانزستور في الحالة العادية : نكتب قانون إضافية التوترات بين A و E :

$$E = (R_B + R_1) I_B + U_{BE}$$

$$I_B = \frac{E - U_{BE}}{R_B + R_1} \approx 4 \cdot 10^{-6} \text{ A} \quad \text{نستنتج :}$$

وتكون شدة التيار في دائرة المجمع، أي في المصباح،

$$I_C < I = 0,3 \text{ A} \quad , \quad I_C = \beta \cdot I_B = 4 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

إذن المصباح لا يضيئ.

3 من الاستعمالات الممكنة للتركيب : كاشف الضوء.....

تمرين-5

باعتبار قانون أوم بين B و E ، نكتب : $I_2 = \frac{U_{BE}}{R_1}$

$$I_1 = I_B + \frac{U_{BE}}{R_1} \quad \text{نحصل على :}$$

$$I_1 = 2.10^{-3} \text{ A} \quad \text{ت.ع، نجد :}$$

(3.1) نكتب قانون إضافية التوترات بين A و E :

$$U_{AE} = U_{AB} + U_{BE}$$

ويكتب قانون أوم : $U_{AE} = E$ و $U_{AB} = R_1 I_1$

باعتبار قانون أوم بين B و E ونحصل على : $I_2 = \frac{U_{BE}}{R_2} = 3.10^{-3} \text{ A}$

و بالنسبة للموصل الاومي (AB) : $I_1 = \frac{E - U_{BE}}{R} = 2.10^{-3} \text{ A}$

نلاحظ أن $I_1 < I_2$ ، وهذا يعني أن تيار القاعدة يبرد على العقدة

B ، الامر الذي يتناقض ونوع الترانزستور. إذن افتراضنا الاول خاطئ. ونستنتج أن الترانزستور متوقف.

(2.2) يمكن استعمال التركيب كمؤشر للبرودة (ينذر بانخفاض درجة الحرارة)

(1.1) المصباح مضى : $I_C = I = 0.2 \text{ A}$

وباعتبار اشتغال الترانزستور عاديا ،

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \quad \text{نجد :} \quad I_B \approx 10^{-3} \text{ A}$$

(2.1) يصل الى العقدة B التيار ذي الشدة $I_{AB} = I_1$ وينطلق منها

تياران : تيار القاعدة شدته I_B و التيار المار في CTN ، شدته I_2 .

يكتب قانون العقد : $I_1 = I_B + I_2$

نحصل على : $E = R_1 I_1 + U_{BE}$

$$R = \frac{E - U_{BE}}{I_1} \quad \text{نتج :}$$

$$R = 1950 \Omega \quad \text{ت.ع، نجد :}$$

(1.2) عند ارتفاع درجة حرارة CTN ، تنقص مقاومتها ، إذن تزيد

قيمة الشدة I_2 وتنقص قيمة I_B .

نتج أن الترانزستور لا يمكن أن يكون إلا متوقفا أو في الحالة العادية.

تتعرض الترانزستور في الحالة العادية : $U_{BE} = 0.6 \text{ V}$